

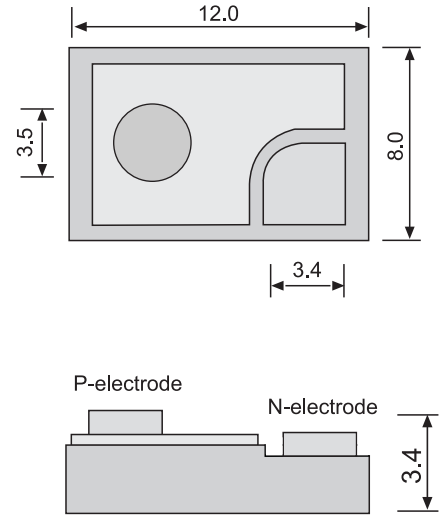


◆ 产品特点:

- 高亮度、长寿命
- 低电流驱动, 损耗小
- 户内外应用
- 芯片百分百测试分选
- 波长和光强良好的一致性

◆ 物理参数:

P电极	金
N电极	金
芯片尺寸	12mil x 8mil (305 ± 20μm x 200 ± 20μm)
芯片厚度	3.4mil (85μm ± 15μm)
焊盘尺寸	3.5mil (90 ± 10μm) in diameter



单位: mil

◆ 光电参数: ($T_C=22^\circ\text{C}$, $I_F=20\text{mA}$)

产品型号	波长范围 (λ_D , nm)		工作电压 (V_F , V)	反向漏电流 (I_R , μA) @ $V_R=10\text{V}$	半波宽度 ($\Delta\lambda$, nm)	最大电流 (I_F , mA) DC
	Min	Max				
S-12CGAUT*-500E**	500	505	3.0 - 3.5	≤ 2	30	25
S-12CGAUT*-505E**	505	510				
S-12CGAUT*-510E**	510	515				
S-12CGAUT*-515E**	515	520				
S-12CGAUT*-520E**	520	525				
S-12CGAUT*-525E**	525	530				

◆ 光强等级: ($T_C=22^\circ\text{C}$, $I_F=20\text{mA}$)

等级:	F1: 70-80	G1: 100-120	H1: 140-160	I1: 160-180	J1: 200-220	K1: 240-270	L1: 300-330
I_V 范围(mcd)	F2: 80-100	G2: 120-140		I2: 180-200	J2: 220-240	K2: 270-300	L2: 330-360

◆ 其它说明

- 光电参数均系三安光电测试仪器在晶圆条件下测试, 98%符合标称值范围
- 芯片封装工艺最高温度低于 280°C , 持续时间小于10秒
- GaN LED 芯片为静电敏感产品, 使用、运输时注意静电防护
- 主波长测量误差 $\pm 1.0\text{nm}$
- 可根据客户要求订做特殊规格的芯片